

97-0252

Invenția se referă la domeniul tehnicii radioelectronice și poate fi utilizată pentru fabricarea fotoreceptoarelor și aparatelor optoelectronice pe baza lor.

Esența invenției constă în aceea că în procedeul de obținere a heterostructurilor în strat subțire pe baza compușilor A^2B^5 , ce include depunerea straturilor în vacuum în prezența gradientului de temperatură între vaporizator și substrat, mai întâi se depune un strat de componentă cu bandă îngustă, se prelucrează în soluție de sare, se arde și se corodează, apoi se depune un strat de componentă cu bandă largă.

Rezultatul tehnic al invenției constă în majorarea numărului de purtători de sarcină.